

パワーMOS FET

■概要

XP152A12C0MR-G は、低オン抵抗、超高速スイッチング特性を実現した P チャネルパワーMOS FET です。スイッチング速度の高速化ができ、セットの高効率化、省エネルギー化を図ることが可能です。

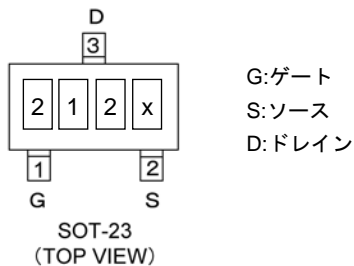
静電対策としてゲート保護ダイオードを内蔵しております。

パッケージはミニモールド SOT-23 を使用しており高密度実装を可能にしています。

■用途

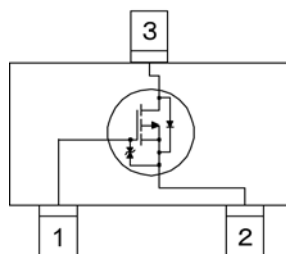
- ノートブック PC
- 携帯電話
- オンボード電源
- Li イオン電池

■端子配列/マーキング



* x は製造ロットを表す。

■等価回路



P チャネル MOSFET
(1 素子内蔵)

■特長

低オン抵抗 : $R_{ds(on)} = 0.3\Omega @ V_{gs} = -4.5V$
: $R_{ds(on)} = 0.5\Omega @ V_{gs} = -2.5V$

超高速スイッチング

駆動電圧 : -2.5V 駆動

P チャネル パワーMOS FET

DMOS 構造

ゲート保護ダイオード内蔵

パッケージ : SOT-23

環境への配慮 : EU RoHS 指令対応、鉛フリー

■製品名

製品名	パッケージ	発注単位
XP152A12C0MR	SOT-23	3,000/Reel
XP152A12C0MR-G*	SOT-23	3,000/Reel

(*) "-G" は、ハロゲン&アンチモンフリーかつ RoHS 対応製品です。

■絶対最大定格

Ta = 25°C

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	Vdss	-20	V
ゲート・ソース間電圧	Vgss	±12	V
ドレイン電流 (DC)	Id	-0.7	A
ドレイン電流 (パルス)	Idp	-2.8	A
逆ドレイン電流	Idr	-0.7	A
許容チャネル損失 *	Pd	0.5	W
チャネル温度	Tch	150	°C
保存温度	Tstg	-55~150	°C

* セラミック基板実装時

■電気的特性

DC 特性

Ta = 25°C

項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレイン遮断電流	Idss	Vds= -20V, Vgs= 0V	-	-	-10	μA
ゲート・ソース間漏れ電流	Igss	Vgs= ±12V, Vds= 0V	-	-	±10	μA
ゲート・ソース間カットオフ電圧	Vgs(off)	Id= -1mA, Vds= -10V	-0.5	-	-1.2	V
ドレイン・ソース間オン抵抗 **	Rds(on)	Id= -0.4A, Vgs= -4.5V	-	0.23	0.30	Ω
		Id= -0.4A, Vgs= -2.5V	-	0.37	0.50	Ω
順伝達アドミタンス **	Yfs	Id= -0.4A, Vds= -10V	-	1.5	-	S
ボディドレインダイオード 順方向電圧	Vf	If= -0.7A, Vgs= 0V	-	-0.8	-1.1	V

** パルステスト

ダイナミック特性

Ta = 25°C

項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力容量	Ciss	Vds= -10V, Vgs=0V f= 1MHz	-	180	-	pF
出力容量	Coss		-	120	-	pF
帰還容量	Crss		-	60	-	pF

スイッチング特性

Ta = 25°C

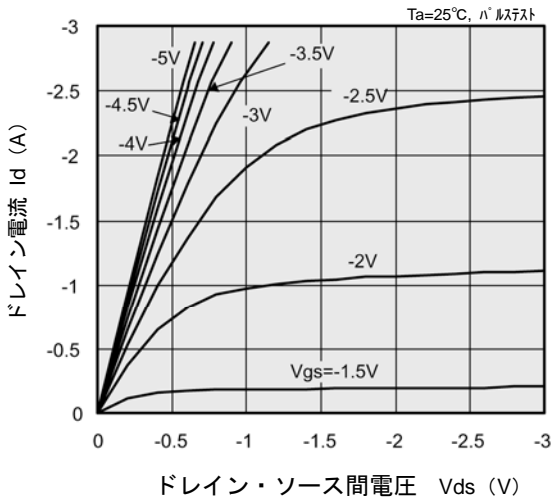
項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ターンオン遅延時間	td (on)	Vgs= -5V, Id= -0.4A Vdd= -10V	-	5	-	ns
上昇時間	tr		-	20	-	ns
ターンオフ遅延時間	td (off)		-	55	-	ns
下降時間	tf		-	70	-	ns

熱特性

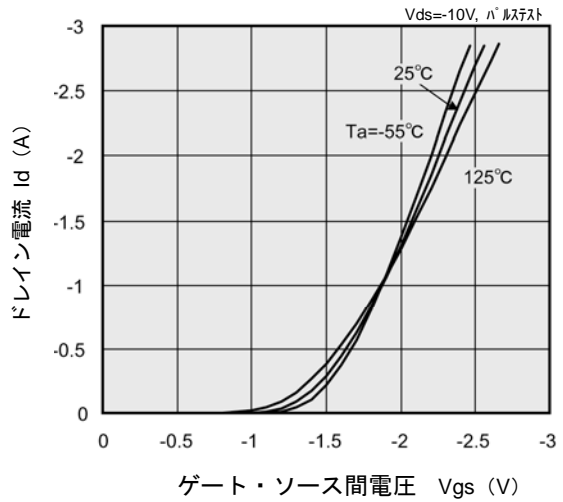
項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
熱抵抗(チャネルー周囲)	Rth (ch-a)	セラミック基板実装	-	250	-	°C/W

■ 特性曲線

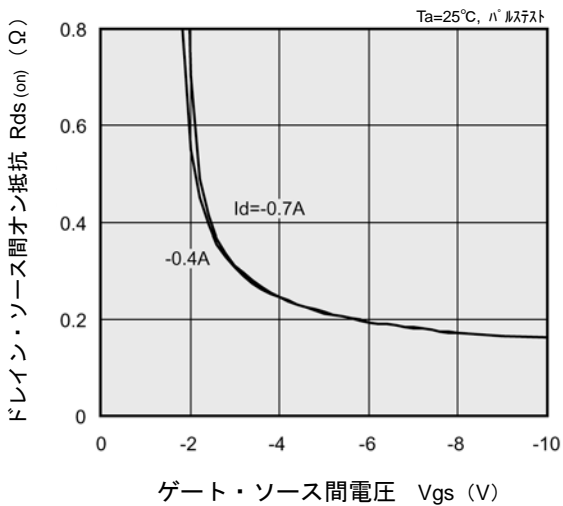
(1) ドレイン電流－ドレイン・ソース間電圧 特性例



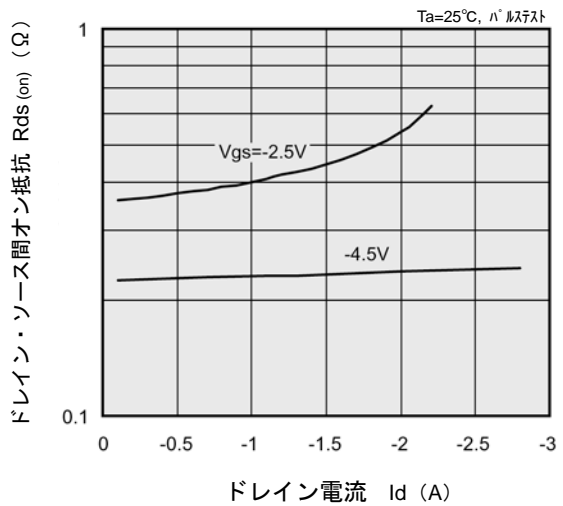
(2) ドレイン電流－ゲート・ソース間電圧 特性例



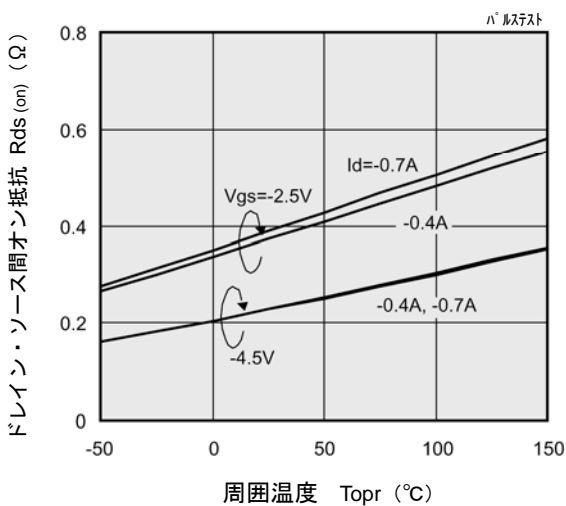
(3) ドレイン・ソース間オン抵抗－ゲート・ソース間電圧 特性例



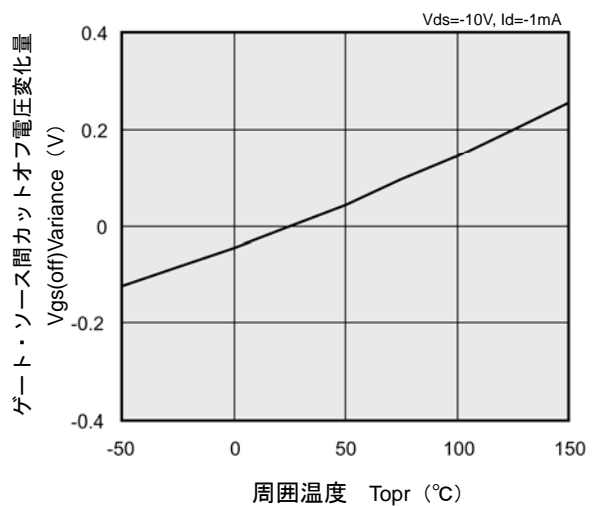
(4) ドレイン・ソース間オン抵抗－ドレイン電流 特性例



(5) ドレイン・ソース間オン抵抗－周囲温度 特性例

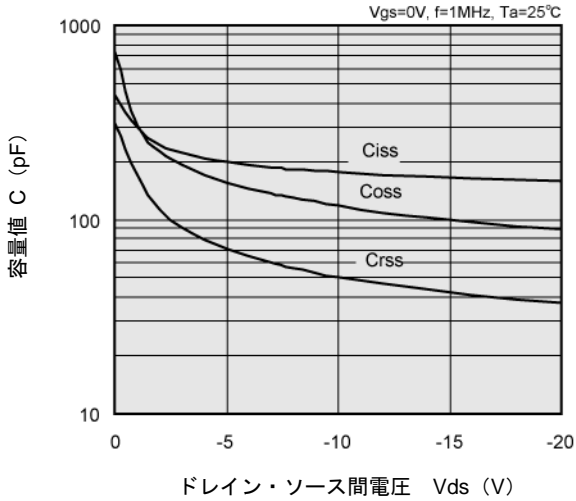


(6) ゲート・ソース間カットオフ電圧変化量－周囲温度 特性例

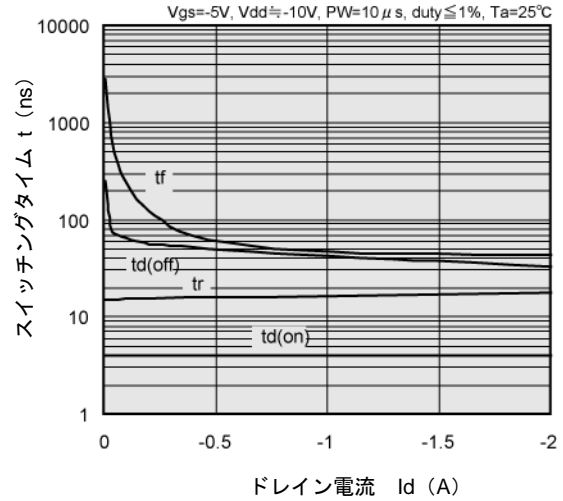


■ 特性曲線

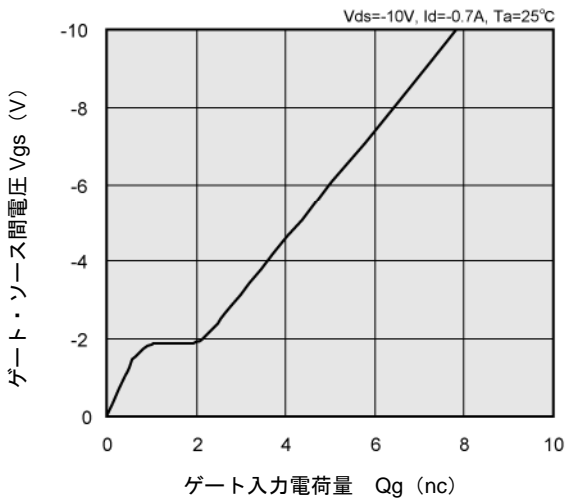
(7) 容量値—ドレイン・ソース間電圧 特性例



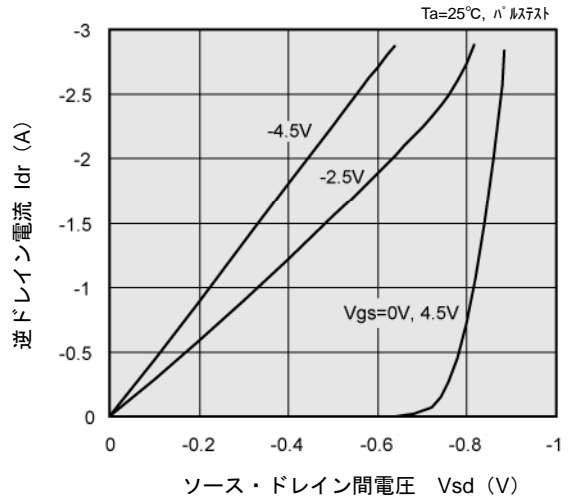
(8) スイッチングタイム—ドレイン電流 特性例



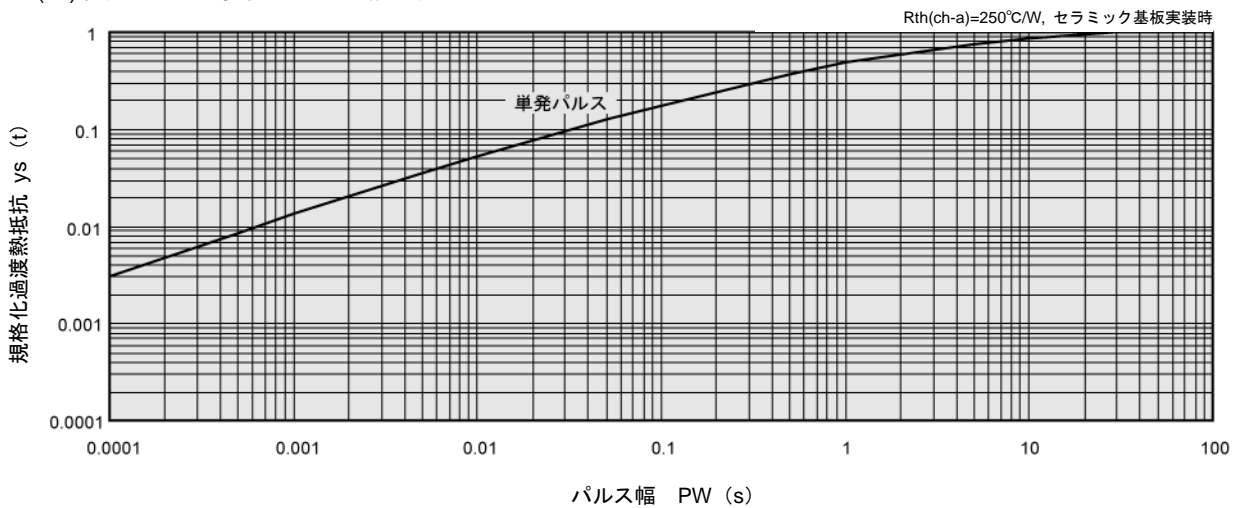
(9) ゲート・ソース間電圧—ゲート入力電荷量 特性例



(10) 逆ドレイン電流—ソース・ドレイン間 特性例



(11) 規格化過渡熱抵抗—パルス幅 特性例



1. 本書に記載された内容(製品仕様、特性、データ等)は、改善のために予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、その最新情報を当社または当社代理店へお問い合わせ下さい。
2. 本書に記載された技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するものであり、工業所有権、その他の権利に対する保証または許諾するものではありません。
3. 本書に記載された製品は、通常の信頼度が要求される一般電子機器(情報機器、オーディオ/ビジュアル機器、計測機器、通信機器(端末)、ゲーム機器、パーソナルコンピュータおよびその周辺機器、家電製品等)用に設計・製造しております。
4. 本書に記載の製品を、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を脅かす恐れのある装置やシステム(原子力制御、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、生命維持装置を含む医療機器、各種安全装置など)へ使用する場合には、事前に当社へご連絡下さい。
5. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。
6. 保証値を超えた使用、誤った使用、不適切な使用等に起因する損害については、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
7. 本書に記載された内容を当社に無断で転載、複製することは、固くお断り致します。

トレックス・セミコンダクター株式会社